【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-513697(P2005-513697A)
【公表日】平成17年5月12日(2005.5.12)
【年通号数】公開・登録公報2005-018
【出願番号】特願2003-553566(P2003-553566)
【国際特許分類】
Ｇ１１Ｂ　7/24　(2006.01)
Ｇ１１Ｂ　7/253　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３１Ｚ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５２２Ａ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５２６Ａ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３５Ａ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３５Ｅ
Ｇ１１Ｂ　7/24　５３５Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成17年10月4日(2005.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ある基板組成及びある基板厚さを有するプラスチック基板（１０８）、
基板組成とは異なる層組成を有する光学層（１１４）、
それらの間に配置されたデータ記憶層（１０２）、並びに
データ記憶層（１０２）と基板（１０８）の間に配置された反射層（１１）
を含んでなり、ラジアル偏差が半径５５ｍｍで１．１５度以下である、記憶媒体（５）。
【請求項２】
光学層（１１４）対基板（１０８）の剛性比が室温における引張変形で測定して０．５～５である、請求項１記載の記憶媒体（５）。
【請求項３】
光学層（１１４）対基板（１０８）の膨潤比が０．５～５．０である、請求項１記載の記憶媒体（５）。
【請求項４】
光学層（１１４）の層厚が基板（１０８）の厚さの２０％以上である、請求項１記載の記憶媒体（５）。
【請求項５】
光学層（１１４）の層厚が０．２μｍ～０．６ｍｍである、請求項１記載の記憶媒体（５）。
【請求項６】
基板（１０８）の厚さが０．３～２．５ｍｍである、請求項１記載の記憶媒体（５）。
【請求項７】
光学層（１１４）がある層厚を有していて、その層厚と基板厚さとの厚さ比が０．００１以上１未満である、請求項１記載の記憶媒体（５）。

【請求項８】
前記層組成及び基板組成が、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、並びにこれらのプラスチックを１種以上含むホモポリマー、コポリマー、反応生成物及び組合せからなる群から個別に選択されるプラスチックである、請求項１記載の記憶媒体（５）。
【請求項９】
前記熱可塑性樹脂が、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンとポリプロピレンのコポリマー、塩素化ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリメチルペンタン、エチレン－テトラフルオロエチレンコポリマー、ポリフッ化ビニル、ポリフッ化ビニリデン、ポリ塩化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、エチレン－酢酸ビニルコポリマー、ポリ酢酸ビニル、ジエン系ポリマー及びコポリマー、ポリブタジエン、ポリイソプレン、エチレン性不飽和カルボン酸のポリマー、エチレン性不飽和カルボン酸を含有するポリマーの官能性誘導体、アクリルポリマー、ポリ（アクリル酸アルキル）、ポリ（メタクリル酸アルキル）、ポリアクリルアミド、ポリアクリロニトリル、ポリアクリル酸、アルケニル芳香族ポリマー、ポリスチレン、ポリ－α－メチルスチレン、水素化ポリスチレン、シンジオタクチック及びアタクチックポリスチレン、ポリシクロヘキシルエチレン、スチレン－コ－アクリロニトリル、スチレン－コ－無水マレイン酸、ポリビニルトルエン、ゴム変性ポリスチレン、ポリアミド、ナイロン－６、ナイロン－６６、ナイロン－１１、及びナイロン－１２、ポリアセタール、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリシクロヘキシルメチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリエステルカーボネート、高耐熱性ポリカーボネート、ポリエーテル、ポリアリーレンエーテル、２，６－ジメチルフェノールから誘導されたポリフェニレンエーテル及び２，３，６－トリメチルフェノールとのコポリマー、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、及びポリエーテルイミド、ポリアリーレンスルフィド、ポリスルホン、及びポリスルフィドスルホン、液晶ポリマー、並びにこれらの熱可塑性樹脂を１種以上含むホモポリマー、コポリマー、反応生成物、組合せ及び複合材からなる群から選択され、前記熱硬化性樹脂が、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アルキド樹脂、ポリエステル、ポリイミド、ポリウレタン、鉱物充填シリコーン、ビス－マレイミド、シアネートエステル、多官能性アリル化合物、アクリル、アルキド、フェノール－ホルムアルデヒド、ノボラック、レゾール、ビスマレイミド、メラミン－ホルムアルデヒド、尿素－ホルムアルデヒド、ベンゾシクロブタン、ヒドロキシメチルフラン、イソシアネート、ベンゾシクロブテン樹脂、並びにこれらの熱硬化性樹脂を１種以上含むホモポリマー、コポリマー、反応生成物及び組合せからなる群から選択される、請求項８記載の記憶媒体（５）。
【請求項１０】
ある基板組成及びある基板厚さを有するプラスチック基板（１０８）、
　前記基板組成とは異なる層組成及び前記基板厚さとは異なる層厚を有する光学層（１１４）、
　それらの間に配置されたデータ記憶層（１０２）、並びに
　データ記憶層（１０２）と基板（１０８）の間に配置された反射層（１１）
を含んでなり、ラジアル偏差が半径５５ｍｍで１．１５度以下である、記憶媒体（５）。